

(1-1) المقدمة

(Introduction)

عني الباحثون بدراسة المواد شبه الموصلة واسهموا إسهاماً كبيراً في تطويرها عن طريق إعطاء فكرة واضحة عن خواصها الفيزيائية والكيميائية اذ تعد فيزياء الأغشية الرقيقة فرعاً مهماً وفريداً من فروع فيزياء الحالة الصلبة [1]. يستعمل مصطلح الغشاء الرقيق (Thin Film) لوصف طبقة أو عدة طبقات من ذرات مادة معينة لا يتعدى سمكها مايكروناً واحداً [2،3]، وترسب الأغشية على مواد صلبة تعرف بالقواعد (Substrates) التي تعتمد على طبيعة الدراسة، ومن هذه المواد الزجاج، الكوارتز، السيليكون، الألمنيوم وبعض المعادن والبوليمرات [4]. نظراً لصغر حجمها وخفة وزنها حيث استخدمت الأغشية الرقيقة في المجالات العلمية والتقنية وكذلك أسهمت في التطور الحالي في مجال الحاسبات الإلكترونية الرقمية (Digital Computers) [5]، و تم استخدامها في صناعة الترانستورات (Transistors) والدوائر المتكاملة (Integrated Circuits) وفي أجهزة الذاكرة المغناطيسية وفي دوائر الفتح والغلق وفي المضخمات (Amplifiers) والكواشف (Detectors) والخلايا الشمسية (Solar Cells)، وكذلك في المجالات البصرية استخدمت الأغشية الرقيقة في صناعة المرشحات البصرية (Optical Filters) التي بدورها تتضمن تصميم مضادات الانعكاس (Antireflection) والمرايا والمرشحات القطعية كما تم استخدام الأغشية الرقيقة في عمليات التداخل (Interference) التي وظفت في عملية التصوير الفوتوغرافي وأجهزة الاستنساخ [6،7].

تعددت طرائق تحضير الأغشية الرقيقة فمنها المعقدة ومنها البسيطة، وبناءً على ما تم ذكره عن أهمية الأغشية الرقيقة في كثير من التطبيقات وفي العديد من المجالات ، وأن اختيار طريقة دون غيرها يعتمد على عوامل عدة، منها الغرض من تحضير الغشاء ، المادة المستخدمة في التحضير وكلفة التحضير [2].

إن زيادة التطور والتقدم العلمي و التكنولوجيا ادى الى تطور طرق تحضير الأغشية الرقيقة فأصبحت على درجة عالية من الدقة في تحديد سمك الغشاء وتجانسه، وتعددت طرائق تحضيرها ولكل طريقة خصوصياتها لتؤدي الغرض الذي استخدمت من أجله، ويتم تحضير الأغشية الرقيقة بالطرق الفيزيائية والكيميائية والتي اورد قسماً منها كما يلي :

أولاً: الطرق الفيزيائية (Physical Methods) وتشمل [8] :

1- الترنيد (Sputtering)

2- التبخير الحراري في الفراغ (Thermal Evaporation In Vacuum)

ثانياً: الطرق الكيميائية (Chemical Methods) وتشمل [9] :

- 1- ترسيب المحاليل الغروية (Sol-Gel Deposition)
 - 2- ترسيب البخار الكيميائي ((Chemical Vapor Deposition (CVD))
 - 3- تقنية التحلل الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis)
 - 4- الترسيب الكهربائي (Electrical Deposition)
 - 5- الإنماء من الأملاح المذابة (Growth from Melted Salts)
- وتم استخدام طريقة تقنية التحلل الكيميائي الحراري في بحثنا لتحضير أغشية رقيقة من مادة أكسيد الكاديوم وذلك لسهولة تحضير هذه المادة وقلّة تكلفتها وتتطلب هذه الطريقة توفير المواد اللازمة لتحضير الأغشية الرقيقة منها بشكل محلول يمكن ترديدها على قواعد من الزجاج .

(2-1) التحلل الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis)

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً في تحضير الأغشية الرقيقة، وتتلخص هذه الطريقة بترسيب محلول المادة المراد تحضير الغشاء منها على قاعدة ساخنة بدرجة حرارة مناسبة تكون أقل من درجة حرارة تطاير المادة، ومن خلال التفاعل الكيميائي بين المادة ودرجة الحرارة يتكون الغشاء الرقيق، وتمتاز الأغشية المحضرة بهذه الطريقة بالتصاقها القوي مع القاعدة، ويمكن التحكم بسمك الغشاء عن طريق السيطرة على مدة الترسيب وعدد الرشّات،

وتمتاز هذا الطريقة عن الطرائق التحضير الأخرى بما يلي [8]:

- بساطة وقلّة تكاليف الأجهزة المصنعة والمستخدمه لتحضير الاغشية مقارنة بتكاليف الأجهزة المستخدمة في الطرائق الأخرى.
- تكون الأغشية المحضره ذات تجانس جيد وبمساحات واسعة.
- تكون مناسبة لتحضير اغشية العديد من المركبات لاسيما الاكاسيد والكبريتات.
- يمكن تحضير اغشية رقيقة من مزج مادتين او اكثر او تشويب المواد للحصول على اغشية ذات صفات محددة.
- يمكن تحضير اغشية رقيقة لمركبات ذات درجة انصهار عالية يصعب تحضيرها باستخدام الطرائق الأخرى.

تستخدم هذه الطريقة في تطبيقات عدة لا تحتاج الى النقاوة العالية ولا تعتمد كثيراً على التجانس العالي في طبيعة الغشاء مثل المجمعات الشمسية. حيث تستخدم هذه الطريقة في

تطبيقات الطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا الضوئية والكواشف. وأول من استخدم هذه الطريقة هما الباحثان (Hottle and Hanger) عام (1959) [1].

(3-1) أكاسيد التوصيل الشفافة

(Transparent Conducting Oxides)

إن البحوث الحديثة اتجهت إلى مجموعة أكاسيد التوصيل الشفافة (TCO) وذلك لأهميته التكنولوجية حيث استعمل بصورة كبيرة في العديد من التطبيقات منها النوافذ المعمارية، متحسسات الغاز، لوحات العرض المسطحة، الفوتوفولتائية والمواد الالكترونية ذات الاساس المؤلف من البوليمر [10].

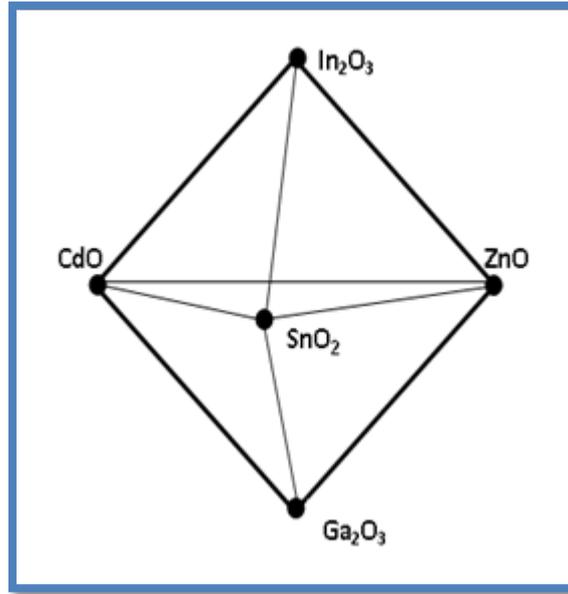
والشفافية الجزئية والتوصيلية الجيدة نسبياً ممكن الحصول عليها من طبقات رقيقة لمختلف انواع المعادن الموكسدة.

وإن هذه الظروف يتم الحصول عليها بشكل مناسب من أكاسيد الكاديوم والقصدير والاندسيوم والخاصين وسبائكها التي تكون على شكل طبقة رقيقة محضرة بتقنية من تقنيات الترسيب. وظهر اول بحث حول الطبقات الموصلة الشفافة عام (1907) من قبل الباحث (Badeker) الذي تناول تحضير أغشية اوكسيد الكاديوم بطريقة الاكسدة الحرارية للكاديوم المرذذ [11].

تستخدم أغشية اوكسيد الكاديوم الرقيقة في العديد من التطبيقات كأحد أكاسيد التوصيل الشفافة (TCO) في التطبيقات الفوتوفولتائية.

إن استخدام اوكسيد الكاديوم كأقطاب شفافة في العديد من التطبيقات التقنية المتقدمة قد جعلت الباحثين يتمعنون في دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والفوتوفولتائية لهذه الأغشية [10].

ويبين الشكل (1-1) مجسم خماسي يضم بعض أكاسيد التوصيل الشفافة، التي تحقق بشكل منفرد وفي المركبات والسبائك كأكاسيد توصيل شفافة مبتكرة ومحسنة.



الشكل (1-1): مجموعة من اكاسيد التوصيل الشفاف [12].

(Cadmium Oxide)

(4-1) اوكسيد الكاديوم

فيما يلي عرض لخصائص مادة اوكسيد الكاديوم وتطبيقاتها:

- مادة اوكسيد الكاديوم احد المركبات الكيميائية للكاديوم، فهي لا تذوب في الماء او في القواعد، ولكنها تذوب في الحوامض واملاح النشادر [13،14] ، وتتفكك عند درجات الحرارة العالية [15].
- يمكن الحصول على مادة اوكسيد الكاديوم عن طريق التسخين الشديد لعنصر الكاديوم [13].
- تعد مادة اوكسيد الكاديوم مادة شبه موصلة من مجموعة الاكاسيد الموصلة الشفافة التي تمتاز بخصائص متميزة كفجوة طاقة كبيرة، تحركية الحاملات العالي، نفاذية عالية في المنطقة المرئية للطيف، توصيلية كهربائية مقاربة لتوصيلية المعادن من النوع السالب (n-type) وخصائص تألق مطلوبة، وذات تطبيقات واسعة في النبائط الكهروبصرية (Opto-Electronic Devices)، النبائط الفوتوفولتائية (Photovoltaic Devices) واجهزة العرض [16].
- ينتمي شبه الموصل اوكسيد الكاديوم الى المجموعة (الثانية-السادسة) (II,VI) من الجدول الدوري [17]، ذو تركيب بلوري مكعب (Cubic) ووحدة خلية متمركزة الأوجه (fcc) وهذا يشابه تركيب بلورة كلوريد الصوديوم (NaCl). [15] كما في الشكل (2-1).



الشكل (2-1): التركيب البلوري لمادة اوكسيد الكاديوم (CdO)[18].

- يمتلك اوكسيد الكاديوم توصيلية عالية بسبب وجود ذرات الكاديوم في مواقع تعويضية (Interstitial) او بسبب فراغات الأوكسجين [17].
- يمتلك اوكسيد الكاديوم معامل امتصاص عالٍ ولهذا السبب يستخدم في المنظومات الشمسية لزيادة كفاءتها في الخلايا الضوئية، وكذلك يستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية مثل خلية (CdO/CdTe) التي تصل كفاءتها الى 7% وكبديل ناجح عن مادة (CdS) في منظومة (SnO₂/CdS/CdTe) ويستخدم كطبقات نافذة (Window Layers) في مفارق الخلايا الشمسية الهجينة (Hetrojunction Solar Cells) وكأقطاب شفافة في تكنولوجيا الخلايا الشمسية [19].

الجدول (1-1) بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لاوكسيد الكاديوم [20].

Appearance	Solid	Melting Point °C	1500
Colour	Brown	Lattice Constant(Å)	4.695
Molecular Weight (g/mol)	128.41	Density (Kg/m ³)	8.115

(Literature Review)

(5-1) الدراسات السابقة

درس (Romero et al., 2001) [21] محلول اسينات الكاديوم للحصول على أغشية (CdO) بطريقة المحلول الغروي (Sol-gel) وترسيبها على قواعد زجاجية وعند درجة حرارة (473K-723K)، بينت نتائج الفحوص التركيبية أن الأغشية المحضرة متعددة التبلور ومن النوع المكعب وذات نفاذية (95-100%) عند الأطوال الموجية التي هي أكبر أو تساوي (600nm)، وكانت أقل قيمة للمقاومية الكهربائية عند (573K) ومقدارها ($10^{-3}\Omega.cm$).

درس (Vigil et al., 2001) [22] أغشية رقيقة من أكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية تقنية التحلل الكيميائي الحراري. ومن ثم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية قبل وبعد المعاملة الحرارية وبينت نتائج حيود الأشعة السينية أن عملية التلدين أدت إلى تحسن الخصائص التركيبية، وأن قيمة فجوة الطاقة البصرية تتناسب طردياً مع مربع معكوس حجم البلورة.

درس الباحثان (Dakhel and Henari, 2003) [23] أغشية أكسيد الكاديوم بطريقة التبخير بالفراغ على قواعد زجاجية في درجة حرارة الغرفة ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية وبدرجات تلدين مختلفة، حيث أظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن الأغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب، وحدد معامل الامتصاص لهذه الأغشية من خلال دراسة منطقة الامتصاص الأساسية في مدى الأطوال (450-650 nm) باستخدام بيانات طيف النفاذية و حددت فجوة الطاقة المباشرة وغير المباشرة وكانت قيمتهما (1.95eV، 2.33eV) على التوالي.

تمكن الباحث (Ghosh et al., 2005) [24] من دراسة تراكيب فائقة الصغر من أغشية أكسيد الكاديوم المحضرة بطريقة تقنية الطلاء بالغطس المحلول- الغروي على قواعد سليكونية أو زجاجية حيث أظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن أغشية أكسيد الكاديوم المحضر هو من النوع المكعب، وكذلك فإن شدة قمم حيود الأشعة السينية تزداد وهذا يعني أن المادة قد تحسن فيها التبلور في درجات الحرارة العالية، وأثبتت صور المجهر الإلكتروني الماسح بأن طور CdO الفائق الصغر بمعدل حجم حبيبي تقع بين (1.6-9.3nm). بين قياس طيف الأشعة فوق البنفسجية/ المرئي أن الأغشية ذات نفاذية عالية تقريباً (75%) في مدى الأطوال الموجية (500-800nm) وبفجوة طاقة مباشرة تقع بين (2.86-3.69eV).

حضر الباحث (Leon- Gutierrez et al., 2006) [25] أغشية أكسيد الكاديوم غير المشوب والمشوب بالقصدير والمحضرة بتقنية الترسيب بالحمام المائي حيث كانت جميع

الأغشية المحضرة متبلورة وبتكوين مكعب لمادة CdO_2 التي تتحول الى CdO بتكوين مكعب من خلال عملية التلدين. وتمتلك الاغشية المحضرة فجوة طاقة بصرية بحدود $(3.6eV)$ ، اما الاغشية غير المشوبة لها فجوة الطاقة تتراوح بين $(2.32-2.54eV)$ ولها توصيلية كهربائية $(8 \times 10^{-4} \Omega.cm)^{-1}$.

درس الباحث (R.S. Ali ., 2008) [26] اغشية (CdO) غير المشوبة والمشوبة بأوكسيد الانتيومون (Sb_2O_3) بنسب حجمية مختلفة $(2, 4, 6 \text{ and } 8\%)$ على قواعد زجاجية بدرجة حرارة $(623K)$ باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري، وباستخدام تقنية حيود الأشعة السينية تم دراسة الخصائص التركيبية للأغشية حيث كانت جميع الاغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب، ودرس اثر التلدين على الخواص البصرية للأغشية عند درجة حرارة $(723K)$ ولمدة ساعة واحدة، حيث وجد ان التلدين ادى الى نقصان فجوة الطاقة لجميع الاغشية المحضرة.

حضرت الباحثتان (سلمى محمد و هدى كاظم ، 2009) [27] اغشية (CdO) باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري، استخدم املاح نترات الكاديوم $(Cd(NO_3)_2)$ مصدرا لايونات الكاديوم (Cd^{+2}) وهيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) كمصدر لايونات الهيدروكسيد (OH^{-2}) وبيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) ، تم دراسة تأثير مختلف ظروف الترسيب مثل درجة حرارة الترسيب، وزمن الترسيب وتركيز ايونات الكاديوم وزمن الاكسدة الحرارية للأغشية والدالة الحامضية على زمن الترسيب والسمك النهائي للأغشية وتحويل هيدروكسيد الكاديوم الى اوكسيد الكاديوم عند اجراء الاكسدة الحرارية للأغشية في الهواء بدرجة حرارة $(573K)$ ولفترة $(15min)$.

درست الباحثة (اسماء احمد عزيز، 2010) [28] تأثير تعرض جسيمات الفا على أغشية اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري، وتبين من دراسة الخصائص البصرية ان فجوة الطاقة تقل بعد التعرض لجسيمات الفا ومع زيادة الجرعة، وتغير عشوائي و طفيف في قيم الخواص البصرية الأخرى.

درس الباحث (R.Kumaravel et al., 2010) [29] اغشية (CdO) المشوبة بالالمنيوم وبنسب حجمية مختلفة $(x=1,2,3,4,6 \text{ and } 5\%)$ باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري، وباستخدام تقنية حيود الأشعة السينية ومجهر القوة الذرية (AFM) وقد بينت دراسة تقنية حيود الأشعة السينية أن الاغشية المحضرة ذات تركيب مكعب مع اتجاه سائد (200) ، واطهرت القياسات البصرية أن قيمة فجوة الطاقة تكون في قيمتها العظمى مقدارها $(2.53eV)$ عند النسبة

(3%) وتقل بزيادة تركيز الشوائب، وبينت القياسات الكهربائية أن أقل قيمة للمقاومة الكهربائية هي $(3.4 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm})$ وتركيز حاملات $(4.12 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3})$ عند نسبة التشويب (3%).

درس الباحث (عبد المجيد عيادة ابراهيم واخرون، 2010) [30] تأثير التشعيع على أغشية اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري، باستخدام أشعة كاما وبطاقة (0.662 Mev) ولفترات زمنية (5min) و(10min) وبعده (24) ساعة، وتبين من دراسة الخصائص البصرية ان فجوة الطاقة بعد التشعيع تقل من (2.49 eV) الى (1.6,1.75,1.85 eV) على التوالي، كما ان التشعيع اثر على ايضا على بعض الخواص البصرية (معامل الامتصاص، الانعكاسية، معامل الخمود) تحديداً بعد الفترة (24) ساعة.

حضر الباحث (عبد المجيد عيادة السامرائي واخرون، 2011) [31] اغشية (CdO) باستخدام طريقة الترسيب بالحمام الكيميائي (CBD)، حيث استخدمت املاح نترات الكاديوم المائية $(\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O})$ مصدرا لايونات الكاديوم (Cd^{+2}) وهيدروكسيد الأمونيوم (NH_4OH) كمصدر لايونات الهيدروكسيد (OH^{-2}) حيث تم دراسة تأثير مختلف ظروف الترسيب مثل درجة حرارة الترسيب وزمن الترسيب وتركيز ايونات الكاديوم وزمن الاكسدة الحرارية للأغشية والسمك النهائي للأغشية وأن افضل فترة زمنية هي (1.5hr) التي يتحول بها هيدروكسيد الكاديوم الى اوكسيد الكاديوم، واجريت الاكسدة الحرارية للأغشية في الهواء بدرجة حرارة (673K). وقد بينت دراسة تقنية حيود الأشعة السينية أن الاغشية المحضرة ذات تركيب مكعب مع اتجاه سائد (111).

حضرت الباحثة (ايمان خير الله سالم، 2012) [32] اغشية (CdO) باستخدام طريقة الترسيب بالحمام الكيميائي (CBD)، ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية، حيث اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الأغشية (CdO) ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب، اما الخواص البصرية فقد تمت دراستها من خلال قياس الامتصاصية ومنها حسب معامل الامتصاص لهذه الأغشية وحددت فجوة الطاقة لغشاء (CdO) وكانت قيمتهما تساوي (2.27eV).

درس الباحث (H. M. Ajeel et al. , 2013) [33] أغشية الكاديوم تيلورايد والمرسب على قواعد زجاجية بواسطة التبخير الحراري بالفراغ، حيث تم دراسة تأثير أشعة كاما بجرعة $(0.5 \mu\text{Ci})$ ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية والبصرية حيث اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الأغشية كانت متبلورة ذات تركيب سداسي، ووجد ان فجوة الطاقة للانتقال المباشر كانت قيمتهما (1.7eV).

درست الباحثة (أزهار حسن و اخرون، 2013) [34] أغشية رقيقة من اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري وتمت دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية، وبينت نتائج حيود الأشعة السينية المجهر الإلكتروني الماسح ومجهر القوة الذرية ومطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية، حيث تبين بأن الغشاء يمتلك حبيبات كروية ذات حجم حبيبي (460nm) وفجوة طاقة (2.49 eV) فبالإضافة إلى ذلك فأن معدل مربع الجذر (RMS) تساوي (58.7nm).

درست (Seham H. S. Ajar, et al., 2015) [35] أغشية رقيقة من اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري. ومن ثم دراسة تأثير التشعيع على الخصائص التركيبية والبصرية حيث اظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن الأغشية المحضرة كانت متعددة التبلور ومن النوع المكعب ووجد ان الحجم الحبيبي يقل بعد التشعيع بأشعة كاما، وبينت دراسة الخصائص والبصرية ان فجوة الطاقة بعد التشعيع تقل بزيادة زمن التشعيع، بينما ازداد كل من معامل الخمود ومعامل الانكسار والتوصيلية البصرية بزيادة زمن التشعيع.

حضر الباحث (وطبان خميس، 2015) [36] أغشية اوكسيد الكاديوم المشوب وغير المشوب بالألمنيوم ($Cd_{1-x}Al_xO$) بطريقتين هما تقنية التحلل الكيميائي الحراري و الترسيب بالحمام الكيميائي على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة (673K) وبدرجة حرارة الغرفة على التوالي وبنسب تشويب حجمية (3,5,7 and 9%) حيث اظهرت نتائج حيود الأشعة السينية ان الأغشية (CdO) ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب وان الاتجاه السائد لكافة الأغشية المشوبة وغير المشوبة هو (111) وأن بزيادة التطعيم تؤدي الى نقصان في شدة القمم، ونلاحظ زيادة في معدل الحجم الحبيبي لكافة الأغشية المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري اما بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي فأن معدل الحجم الحبيبي يزداد بسبب دخول أيونات الألمنيوم كأيونات استبدالية، وبينت فحوصات مجهر القوة الذرية (AFM) لكافة الأغشية بالطريقتين أن معدل خشونة السطح تقل بزيادة نسب التشويب، ومن خلال دراسة الخواص البصرية وجد ان فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح تساوي (2.41eV) للأغشية غير المشوبة وتزداد بزيادة نسب التشويب حتى تصل الى (2.6 eV) عند النسبة (9%).

(6-1) الهدف من البحث (Aim of the Work)

يهدف البحث الحالي إلى تحضير أغشية رقيقة من أوكسيد الكاديوم (CdO) باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري والمرسبة على قواعد من الزجاج بدرجة حرارة (723K) ومن ثم دراسة الخواص التركيبية وتشمل قياسات (XRD) وقياسات مجهر القوة الذرية (AFM)،

وكذلك يهدف البحث الى دراسة الخواص البصرية وتشمل قياس النفاذية والامتصاصية للأغشية المحضرة وحساب كل من معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية وطاقة ذبول اورباخ وحساب الثوابت البصرية المتمثلة بمعامل الانكسار ومعامل الخمود وثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي والانعكاسية فضلاً عن التوصيلية البصرية وشععت كافة النماذج ومن ثم دراسة نفس الخواص انفة الذكر وذلك لمعرفة تأثير التشعيع على الخواص التركيبية والبصرية.



**Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
University of Diyala
College of Science
Department of Physics**



**Study the Effect of Gamma Irradiation
On Some Physical Properties of (CdO) Thin Films
Prepared Chemically Method**

**A Thesis
Submitted To The Council of Education College of
University of Diyala In Partial Fulfillment
of The Degree of M.Sc. In Physics**

By

Eman S.Noore

B. Sc. Physics (2013)

Supervised By

Dr. Bathinah A. Abraham

Assist. Prof.

Dr. Nadir F. Habubi

Prof.

2017